

关键指标

- RF/LO 频段：10.0~20GHz
- IF 频段：DC~4GHz
- 变频损耗：8dB
- 本振功率：+13dBm
- 芯片尺寸：0.9mm×0.68mm×0.1mm

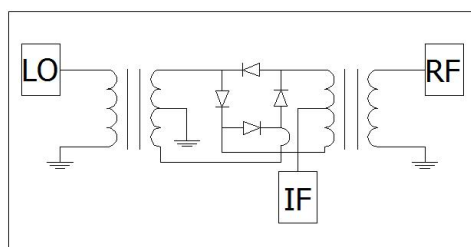
典型应用

- 雷达和电子对抗
- RF/微波电路
- 军事和航天
- 测试仪器
- 仪器仪表

产品简介

XT3506A 是一款 GaAs MMIC 无源双平衡混频器变频芯片，芯片射频频率覆盖 10~20GHz，本振频率覆盖 10~20GHz，中频频率覆盖 DC~4GHz，上下变频损耗小于 8dB，典型本振输入功率为+13dBm。

功能框图



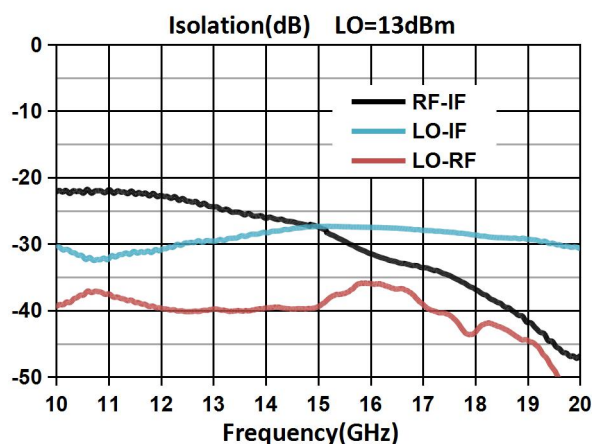
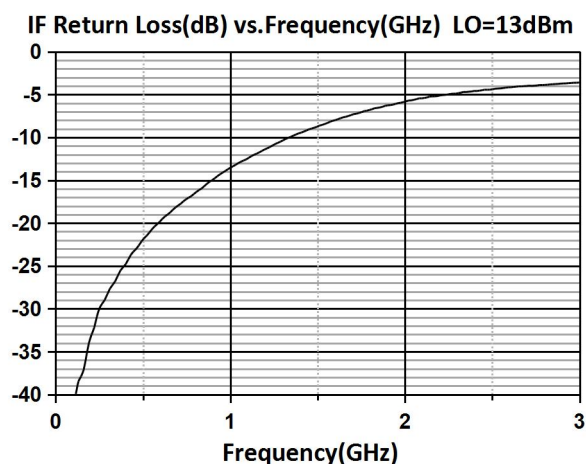
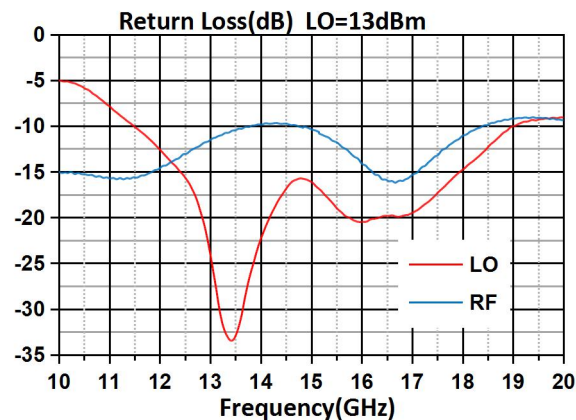
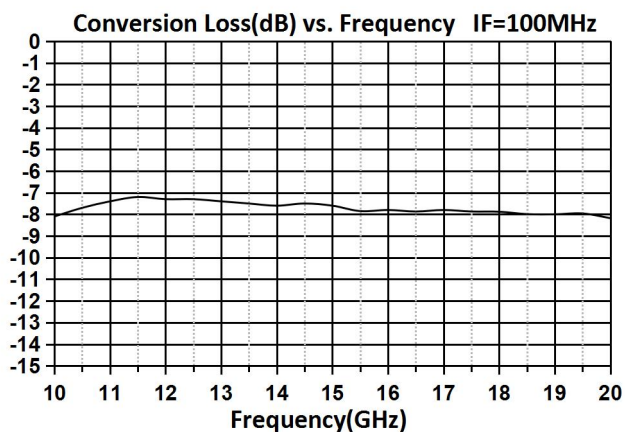
电性能 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $\text{LO}=+13\text{dBm}$)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频频率/本振频率	10~20			GHz
中频频率	DC~4			GHz
变频损耗	—	-7.5	—	dB
RF 回波损耗	—	-15	—	dB
LO 回波损耗	—	-15	—	dB
IF 回波损耗	—	-10	—	dB
RF-IF 隔离度	—	-30	—	dB
LO-IF 隔离度	—	-30	—	dB
LO-RF 隔离度	—	-40	—	dB

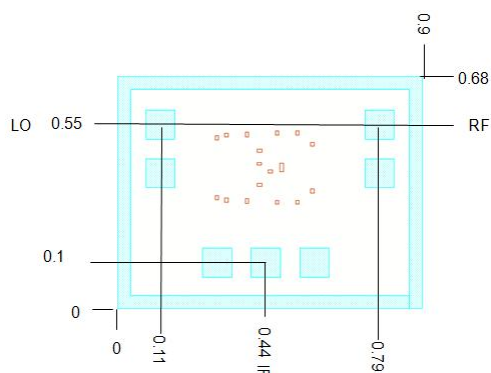
绝对最大额定值

射频最大输入功率	+20dBm	工作温度	-55℃~+85℃
本振最大输入功率	+24dBm	存储温度	-65℃~+150℃

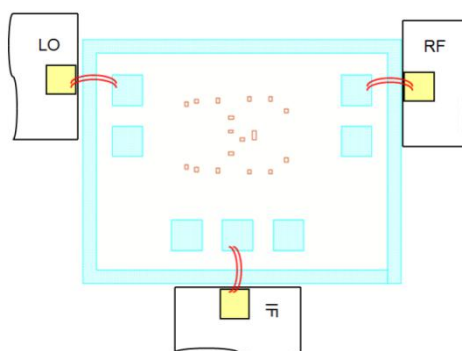
典型测试曲线



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



注意事项

砷化镓 MMIC 器件易受静电放电损伤。在运输、装配和试验过程中应采取防范措施。